2SB966/2SD1289

PNPエピタキシアル/NPN三重拡散形シリコントランジスタ

低周波電力増幅用

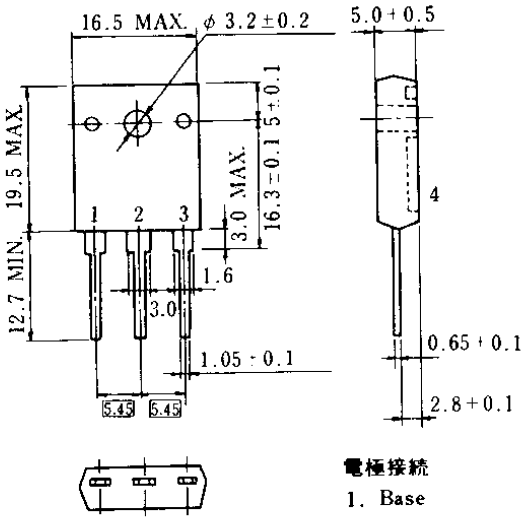
PNP Silicon Epitaxial/NPN Silicon Triple Diffused Transistor
Audio Frequency Amplifier

○実効出力45～55 W(Singl-PP, R_L=8 Ω)のパワーアンプ出力用。

○New EBT構造を採用，f_Tが高く，破壊強度が優れています。

○直流電流増幅率h_{FE}の電流特性が優れています。

外形図／PACKAGE DIMENSIONS
(Unit : mm)



電極接続
1. Base
2. Collector
3. Emitter
4. Fin (Collector)

絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_a=25 ℃)

項　　目	略　号	2SB966	2SD1289	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	−120	120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	−120	120	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	−5.0	5.0	V
コレクタ電流	$I_{C(DC)}$	−8.0	8.0	A
コレクタ電流	$I_{C(pulse)}$ *	−12	12	A
全　損　失	$P_{T(Tc=25\,℃)}$	80		W
ジャンクション温度	T_j	150		℃
保存温度	T_{stg}	−55～+150		℃

＊PW≦10 ms, Duty Cycle≦50 %

電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_a=25 ℃)

2SB966/2SD1289

項　　目	略　号	条　　件	MIN.	TYP.	MAX.	単　位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB}=−120/120 V, I_E=0			−50/50	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB}=−5.0/5.0 V, I_C=0			−50/50	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	V_{CE}=−5.0/5.0 V, I_C=−50/50 mA *	40	150/120		
直流電流増幅率	h_{FE2}	V_{CE}=−5.0/5.0 V, I_C=−1.0/1.0 A *	60	140	320	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=−5.0/5.0 A, I_B=−0.5/0.5 A *		−0.65/0.65	−1.5/1.5	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	I_C=−5.0/5.0 A, I_B=−0.5/0.5 A *		−1.25/1.25	−2.0/2.0	V
コレクタ容量	C_{ob}	V_{CB}=−10/10 V, I_E=0, f=1.0 MHz		200/120		pF
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=−5.0/5.0 V, I_C=−1.0/1.0 A		65/60		MHz

＊パルス測定　PW≦350 μs, Duty Cycle≦2 %
h_{FE2}区分/R：60～120 Q：100～200 P：160～320